

Silicon Standard Recovery Diode

$V_{RRM} = 1000\text{ V} - 1400\text{ V}$

$I_F = 100\text{ A}$

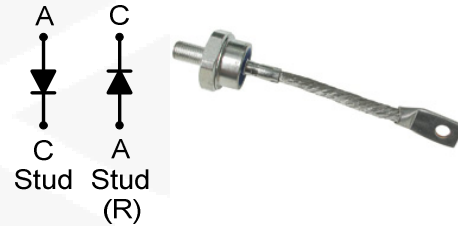
Features

- High Surge Capability
- Types from 1000 V to 1400 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-8 Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	1N3295A(R)	1N3296A(R)	1N3297A(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		1000	1200	1400	V
DC blocking voltage	V_{DC}		1000	1200	1400	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 130\text{ °C}$	100	100	100	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 8.3\text{ ms}$	2300	2300	2300	A
I_2t for fusing	I_2t	60 Hz Half wave	22000	22000	22000	$A^2\text{sec}$
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	1N3295A(R)	1N3296A(R)	1N3297A(R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 100\text{ A}$, $T_j = 130\text{ °C}$	1.5	1.5	1.5	V
Reverse current	I_R	$V_R = V_{RRM}$, $T_j = 130\text{ °C}$	11	9	7	mA

Thermal characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	1N3295A(R)	1N3296A(R)	1N3297A(R)	Unit
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.40	0.40	0.40	$^{\circ}\text{C/W}$

Electrical Characteristics

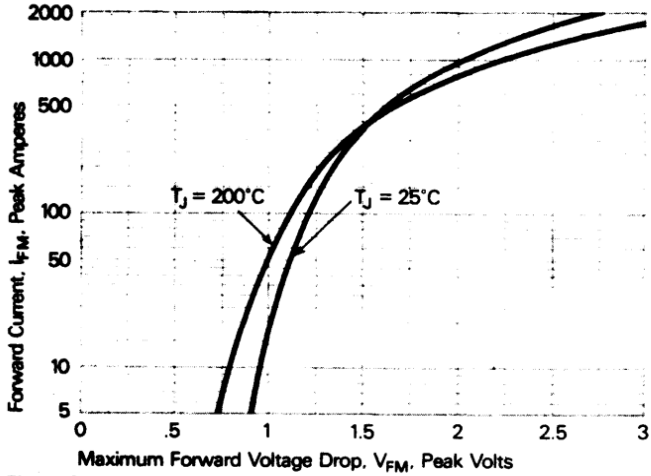


Figure 1. Forward Current vs. Forward Voltage.

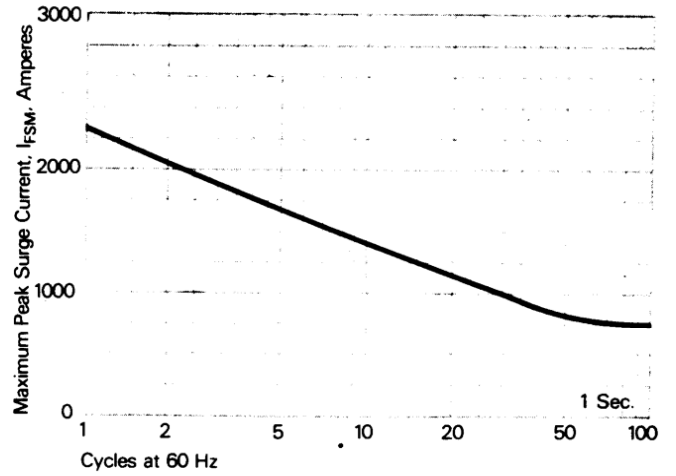


Figure 2. Maximum allowable surge current at rated load conditions.

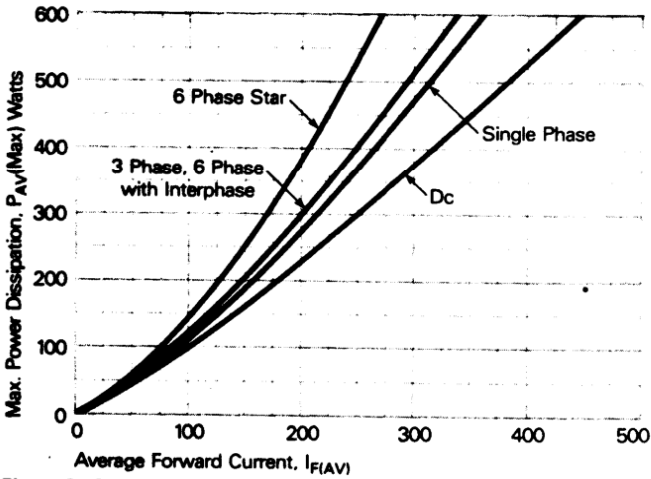


Figure 3. Power dissipation vs. Average forward current.

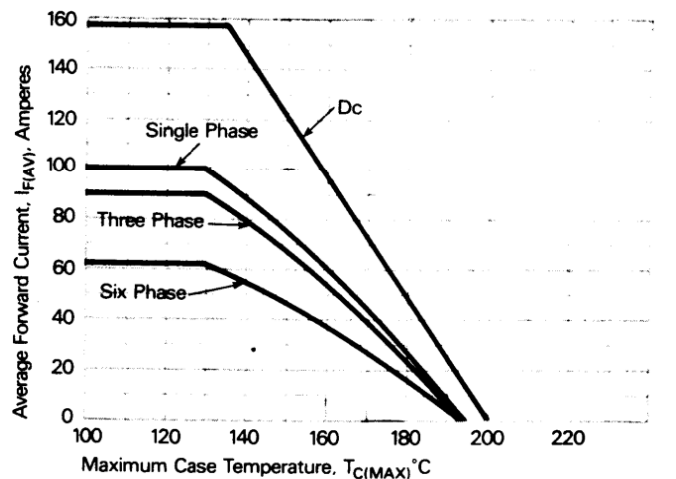


Figure 4. Forward Current vs. Case Temperature.

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	3/8-24 UNF			
B	----	$\phi 0.930$	----	$\phi 23.5$
C	1.050	1.060	26.67	26.92
D	4.300	4.700	109.22	119.38
E	----	0.690	----	17.00
F	0.260	----	6.50	----
G	----	0.940	----	24.00
H	----	0.600	----	15.23
I	0.276	0.286	7.010	7.260

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[1N3295A](#) [1N3295AR](#) [1N3296A](#) [1N3296AR](#) [1N3297A](#) [1N3297AR](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.